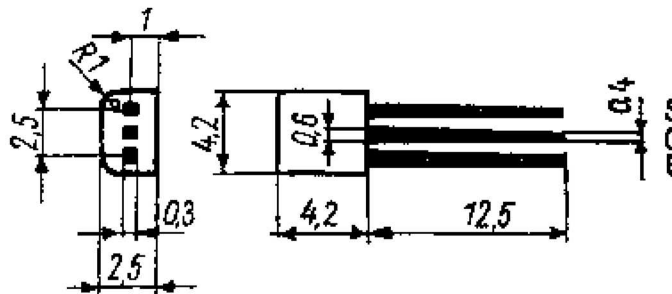


Silizium-MOS-Feldeffekt-Transistor (n-Kanal-Depletion-Typ) mit hoher Eingangsimpedanz für allgemeine Anwendung, Bauform L 3 nach TGL 200—8380. Das Substrat ist innerhalb des Gehäuses mit Source verbunden.



Masse ca. 0,3 g

Wärmewiderstand $R_{thch/a} \leq 0,6 \text{ grad/mW}$

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

Drain-Source-Spannung	U_{DSV}	$= 20 \text{ V}$
Gate-Source-Spannung	U_{GS}	$= -15 \text{ V bis } +5 \text{ V}$
Drain-Gate-Spannung	U_{DG}	$= 32 \text{ V}$
Drainstrom	I_D	$= 15 \text{ mA}$
Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_a = 25^\circ \text{C}$	P_{tot}	$= 150 \text{ mW}$
Kanaltemperatur	ϑ_{ch}	$= +125^\circ \text{C}$
Betriebstemperaturbereich	ϑ_a	$= 0^\circ \text{C bis } +125^\circ \text{C}$

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ \text{C} -5 \text{ grad}$)		Min.	Typ	Max.
Drain-Source-Durchbruchspannung	$U_{(BR)DSV}$	20 V		
$-U_{GS} = 12 \text{ V}$				
$I_D = 10 \mu\text{A}$				
Schwellspannung	$-U_T$		7,5 V	12 V
$U_{DS} = 8 \text{ V}$				
$I_D = 10 \mu\text{A}$				
Drainstrom	I_{DSS}	3 mA	7,5 mA	12 mA
$U_{DS} = 8 \text{ V}$				
$U_{GS} = 0 \text{ V}$				
Eingangswiderstand	R_a	$10^{12} \Omega$	$10^{14} \Omega$	
$-U_{GSS} = 10 \text{ V}$				

Dynamische Kennwerte ($\vartheta_a = 25\text{ °C} -5\text{ grad}$)

Steilheit

y_{21}

1,3 mS

1,7 mS

$U_{DS} = 8\text{ V}$

$U_{GS} = 0\text{ V}$

$f = 1\text{ kHz}$

Eingangskapazität

C_{11}

5,5 pF

6,5 pF

$U_{DS} = 8\text{ V}$

$U_{GS} = 0\text{ V}$

Ausgangskapazität

C_{22}

2,8 pF

$U_{DS} = 8\text{ V}$

$U_{GS} = 0\text{ V}$

$f = 1\text{ MHz}$

Drain-Gate-Rückwirkungskapazität

C_{12}

1,3 pF

$U_{DS} = 8\text{ V}$

$U_{GS} = 0\text{ V}$

$f = 1\text{ MHz}$

Ausgangsleitwert

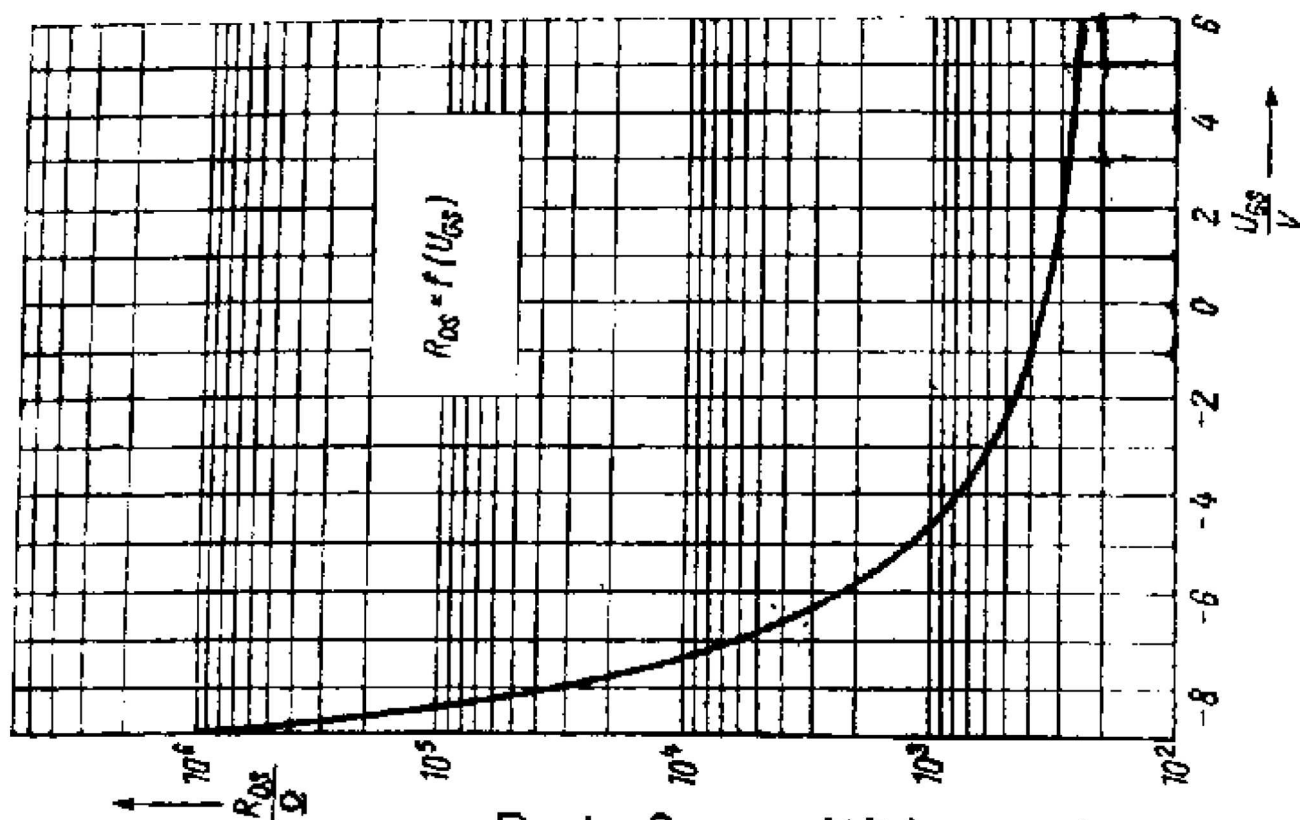
g_{22}

0,154 mS

$U_{DS} = 8\text{ V}$

$U_{GS} = 0\text{ V}$

$f = 1\text{ MHz}$



Drain-Source-Widerstand
bei $U_{DS} = 0,1\text{ V}$

